



PRESSEMITTEILUNG

Veröffentlichung vom November 2022, Business Unit: Power

Stromversorgung

50-mOhm-GaN-FET im TO-263-Gehäuse (D2PAK)

GaN-Halbleiter zeigen ihr volles Potential in Gehäusen mit möglichst geringer parasitärer Induktivität. HY-LINE Power Components erweitert daher das Angebot für solche Schalter um ein Power-SMD-Gehäuse, welches die Vorteile der GaN Technologie optimal nutzen kann.

Bei dem neuen SMD-Bauelement mit höherer Leistung handelt es sich um einen selbstsperrenden 650-V-SuperGaN-FET im TO-263-Gehäuse (D2PAK) mit einem typischen On-Widerstand von 50 Milliohm in Kaskodentechnologie. Es ist der siebte SMD-Baustein von Transphorm, der die Palette der derzeit erhältlichen PQFN-Bauteile für Anwendungen mit geringer bis mittlerer Leistung nach oben ergänzt.

Der JEDEC-qualifizierte TP65H050G4BS bietet Designern und Herstellern Vorteile, die Systeme mit hoher Leistung von einem bis zu mehreren Kilowatt entwickeln, wie sie in industriellen Anwendungen genutzt werden. Er bietet die höchste Zuverlässigkeit in seiner Klasse, ein robustes Gate (± 20 V max) und eine hohe Störfestigkeit von 4 V, wie man sie von Silizium gewohnt ist, bei einfachem Design und Ansteuerbarkeit.

Der größere D2PAK wird eingesetzt, wenn ein oberflächenmontierbares Gehäuse gewünscht ist mit einer besseren thermischen Leistung im Vergleich zum PQFN-Gehäuse.

Mit dem neuen GaNFET im TO-263-Gehäuse steigert sich auch die Leistungsdichte des TDTTP2500B066B-KIT von Transphorm, einer 2,5 kW AC/DC-Totem-Pole-Evaluierungsplatine mit brückenloser Leistungsfaktorkorrektur (PFC).

hy-line-group.com/gan

hy-line-group.com

Pressebild



A10781-09_TO263-GaN-FET.jpg

HY-LINE Power Components
Tel. 089 / 614503-10
Fax 089 / 614503-20
Email: power@hy-line.de